

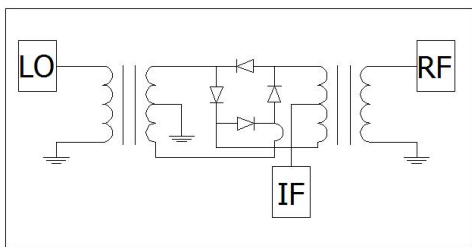
关键指标

- RF/LO 频段：5.0~10GHz
- IF 频段：DC~4GHz
- 变频损耗：8dB
- 本振功率：+13dBm
- 芯片尺寸：1.24mm×0.82mm×0.1mm

典型应用

- 雷达和电子对抗
- RF/微波电路
- 军事和航天
- 测试仪器
- 仪器仪表

功能框图



产品简介

XT3509 是一款 GaAs MMIC 无源双平衡混频器变频芯片，芯片射频频率覆盖 5~10GHz，本振频率覆盖 5~10GHz，中频频率覆盖 DC~4GHz，下变频损耗小于 8dB，典型本振输入功率为+13dBm。

电性能

($T_A=25^{\circ}\text{C}$, $L_0=+13\text{dBm}$, $V_{dd}=+5\text{V}$, 下变频)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
射频/本振频率	5.0~10			GHz
中频频率	DC~4			GHz
变频损耗	—	-8	—	dB
本振-射频隔离度	—	-38	—	dB
本振-中频隔离度	—	-35	—	dB
射频-中频隔离度	—	-15	—	dB

电性能

($T_A=25^{\circ}\text{C}$, $L_0=+13\text{dBm}$, $V_{dd}=+5\text{V}$, 下变频)

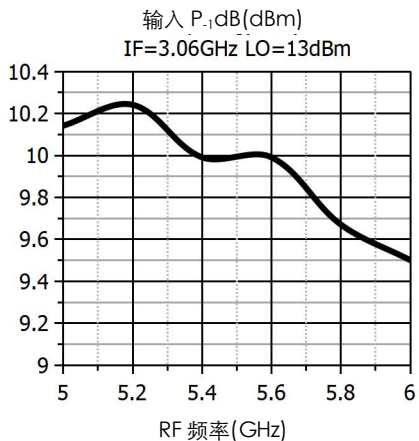
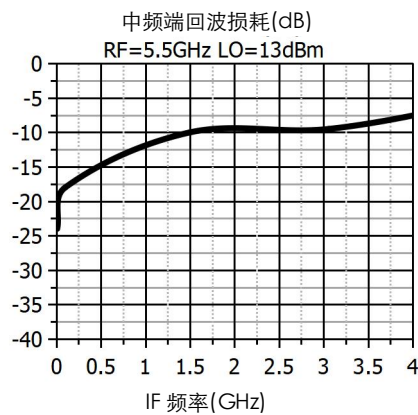
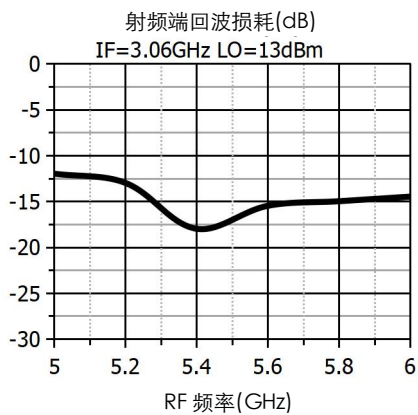
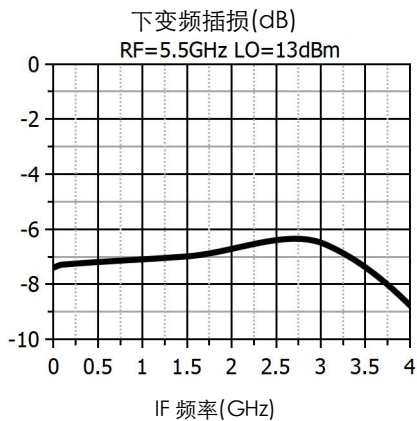
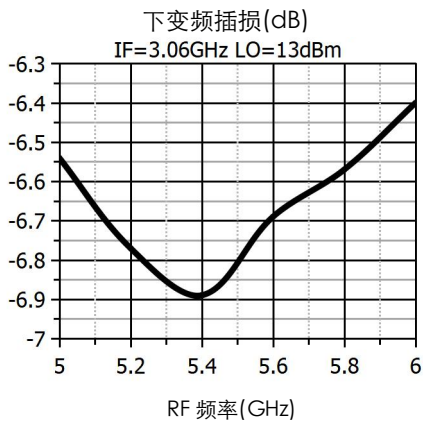
指标	最小值	典型值	最大值	单位
射频/本振频率	5.0~10			GHz
中频频率	DC~4			GHz
变频损耗	—	-8	—	dB
本振-射频隔离度	—	-38	—	dB
本振-中频隔离度	—	-35	—	dB
射频-中频隔离度	—	-15	—	dB

绝对最大额定值

射频最大输入功率	+20dBm	工作温度	-55℃~+85℃
本振最大输入功率	+24dBm	存储温度	-65℃~+150℃
		最大电源电压	+8V

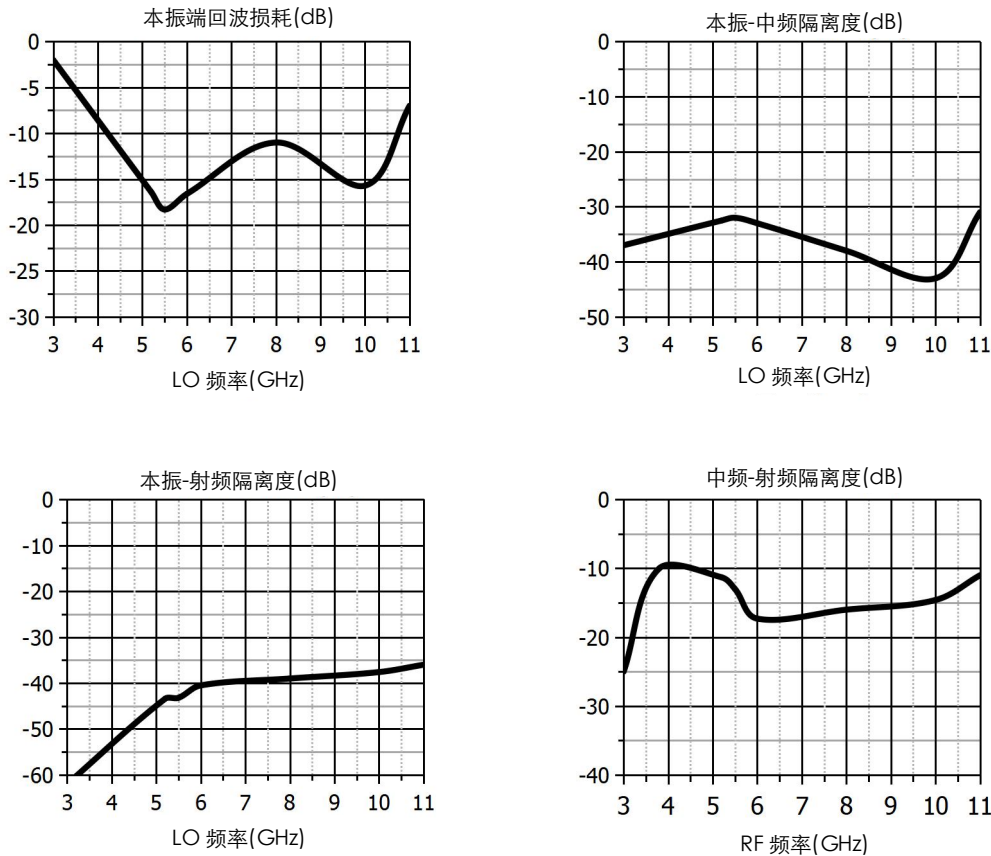
典型测试曲线

(下变频)

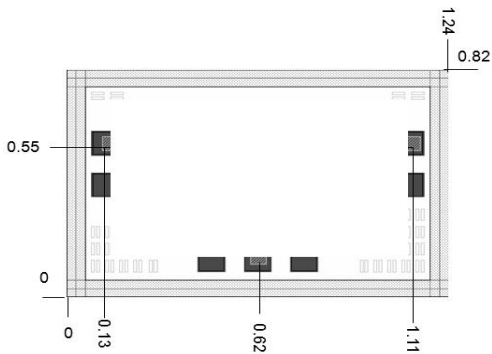


典型测试曲线

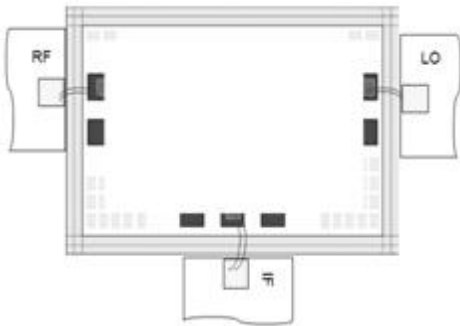
(隔离度)



外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



注意事项

砷化镓 MMIC 器件易受静电放电损伤。在运输、装配和试验过程中应采取防范措施。

